

КТ635Б

кремниевый биполярный
эпитаксиально-планарный
п-р-п транзистор

Назначение

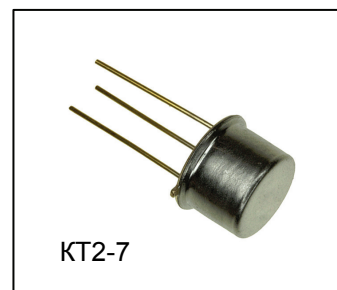
Импульсный переключательный высокочастотный п-р-п транзистор. Предназначен для использования в аппаратуре систем связи и другой радиоэлектронной аппаратуре широкого применения, изготавливаемой для народного хозяйства

Обозначение технических условий

- аАО.336.250 ТУ

Корпусное исполнение

- металлический корпус КТ2-7 (ТО-39)

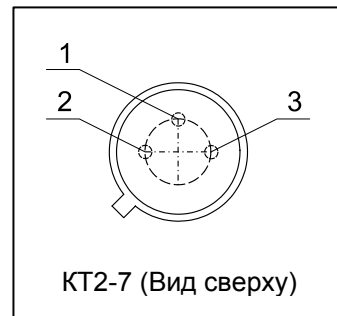


Зарубежный прототип

- прототип 2N3725

Рабочий температурный диапазон

- диапазон температур от -45 до + 85



Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	База
№2	Эмиттер
№3	Коллектор

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ635Б при $T_{\text{окр. среды}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектора	$I_{\text{кбо}}$	мкА	$U_{\text{кб}}=60\text{ В}$	-	30
Статический коэффициент передачи тока	$h_{21\text{E}}$		$U_{\text{кэ}}=1\text{ В}, I_{\text{к}}=500\text{ мА}$	20	150
Граничная частота коэффициента передачи тока	$F_{\text{гр}}$	МГц	$U_{\text{кэ}}=10\text{ В } f=10^8\text{ Гц}$ $I_{\text{к}}=50\text{ мА}$	200	-
Напряжение насыщения коллектор - эмиттер	$U_{\text{кэ(нас)}}$	В	$I_{\text{к}}=500\text{ мА}, I_{\text{б}}=50\text{ мА}$	-	0,9
Обратный ток коллектор-эмиттер	$I_{\text{кэР}}$	мкА	$U_{\text{кб}}=60\text{ В } R_{\text{бэ}}=0$	-	30
Время рассасывания	$t_{\text{рас}}$	нс	$I_{\text{к}}=500\text{ мА } I_{\text{б}}=50\text{ мА}$ $t_{\text{д}} \leq 30\text{ мкс } Q \geq 50$	-	50
Обратный ток эмиттера	$I_{\text{эбо}}$	мкА	$U_{\text{эб}}= 5\text{ В}$	-	20